

MIRDC-103-A211

全球3DIC關鍵設備 技術發展趨勢

作者：陳慧娟

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇三年十二月

目錄

■ 摘要	1
■ 前言	2
■ 矽晶直通孔(TSV)製程技術	3
■ 結論	8



全球 3D IC 關鍵設備技術發展趨勢

金屬中心 MII 產業分析師 陳慧娟

摘要：

為了追求甚至超越摩爾定律(More than Moore' s Law)，新興製程技術-三維積體電路(3D IC)的概念逐漸浮出檯面且其關鍵製程技術亦陸續積極研發中。3D IC 關鍵製程技術包括矽晶直通孔(Through-Silicon-Via,TSV)、晶圓級接合(Wafer Level Bonding)及晶圓薄化(Wafer Thinning)，如何達到各關鍵製程之最佳化將直接影響到整體 3D IC 電路系統整合良率及品質的要求。

《全球 3DIC 關鍵設備技術發展趨勢》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>